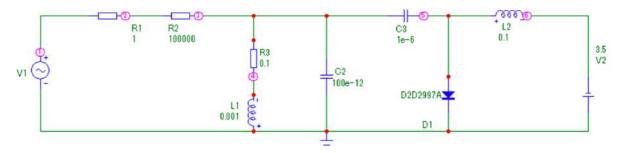
Дисциплина основы электроники

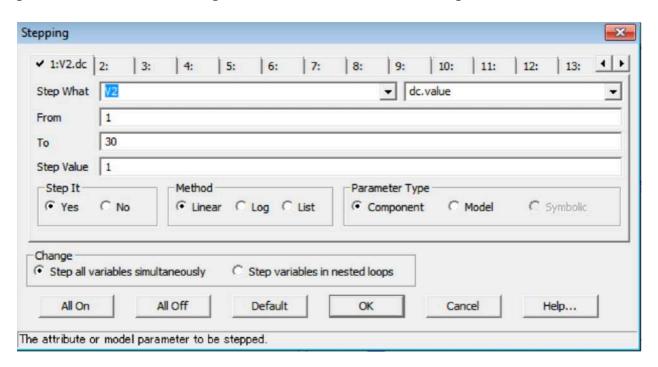
Лабораторный практикум №1 по теме «Полупроводниковые диоды» (Часть 2)

Работу выполнила: студентка группы ИУ7-31Б Варламова Екатерина **Цель работы:** получение в программе схемотехнического анализа Micro-сар 10.0.9.2 и исследование статических и динамических характеристик германиевого или кремниевого полупроводниковых диодов с целью определения по ним параметров модели полупроводниковых диодов. Освоение программы Mathcad для расчёта параметров модели полупроводниковых приборов на основе данных экспериментальных исследований и внесение модели в базу данных программ схемотехнического анализа.

Поскольку данный в задании диод D2d2998a является низкочастотным, возьмём для снятия вольт-фарадной характеристики диод D2d2997a. Для получения ВФХ будем пользоваться схемой, приведенной ниже.



Наша цель – найти емкость диода при приложении к нему различного обратного напряжения. Чтобы осуществить это, для начала, построим обычный параллельный колебательный контур. Подключив диод, мы добавим в параллельную ветвь еще один «конденсатор», эквивалентная емкость будет равняться сумме C1 и Cd. Однако, чтобы диод проявил свою барьерную емкость, необходимо подключить к нему постоянное напряжение. Кроме того, нужно избежать влияния источника постоянного напряжения на остальную цепь, локализовав его действие только на диоде и влияния остальной цепи на источник. Этого мы добьемся путем подключения дополнительных конденсатора С2 (обрывает постоянное напряжение) и катушки L2 (обрывает переменное напряжение). Последовательно меняя приложенное к диоду постоянно напряжение, мы тем самым будем изменять барьерную емкость диода, а, следовательно, и резонансные частоты всей цепи. помощью вспомогательного окна построим график резонансных частот от приложенного постоянного напряжения.



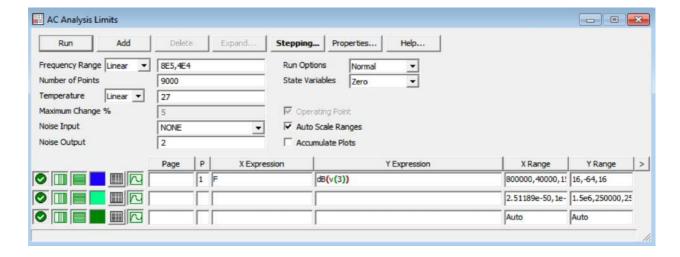
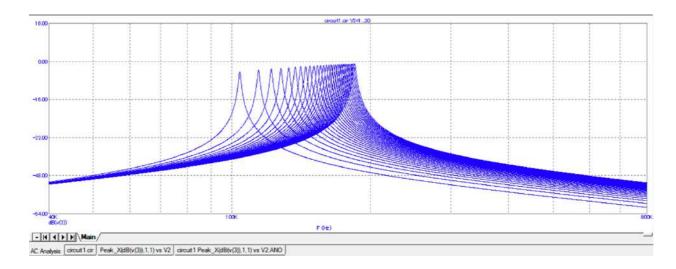
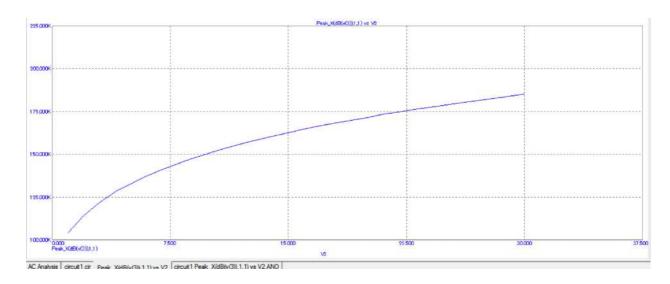


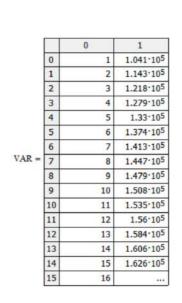
График зависимости резонансных частот от приложенного постоянного напряжения выглядит следующим образом:

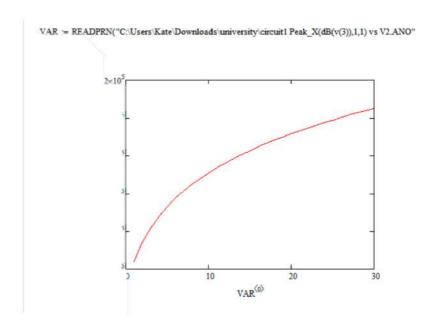


Теперь можем получить резонансную частоту как функцию напряжения источника.



Перенесём полученные результаты в Mathcad.

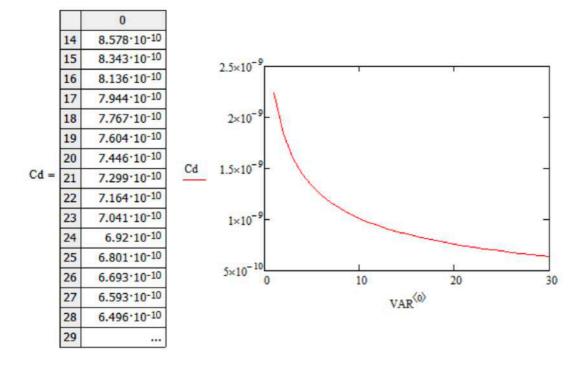




Поскольку резонансная частота определяется по формуле Томпсона, из этой формулы можно вычислить значение ёмкости диода для напряжения управления и построить вольтфарадную характеристику.

Lk :=
$$10^{-3}$$
 Ck := 10^{-10} Frez := VAR $\langle 1 \rangle$

$$Cd := \left(\frac{1}{4 \cdot Frez^2 \pi^2 Lk}\right) - Ck$$



Расчёт параметров барьерной ёмкости можно провести с использованием возможностей MCAD — решение системы нелинейных уравнений с использованием вычислительного блока Given-Find.

Cj :=
$$10^{-12}$$
 Vj := 1 M := 0.41

Given

Cd = Cj $\left[1 - \frac{(-VAR)^{\langle 0 \rangle}}{Vj}\right]^{-M}$
 $0 < Vj < 0.75$
 $\frac{1}{3} < M < \frac{1}{2}$

find (Cj, Vj, M) = $\begin{pmatrix} 3.242 \times 10^{-9} \\ 0.75 \\ 0.437 \end{pmatrix}$

Сравним параметры барьерной ёмкости с данными в архиве диодов:

```
* Variant 02
.model D2d2997a D(Is=292.9p Rs=3.244m Ikf=.6194 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=3.283n
+ M=.4371 Vj=.75 Fc=.5 Isr=17.38u Nr=2 Bv=200.1 Ibv=12.93m
+ Tt=100.1n)
```